

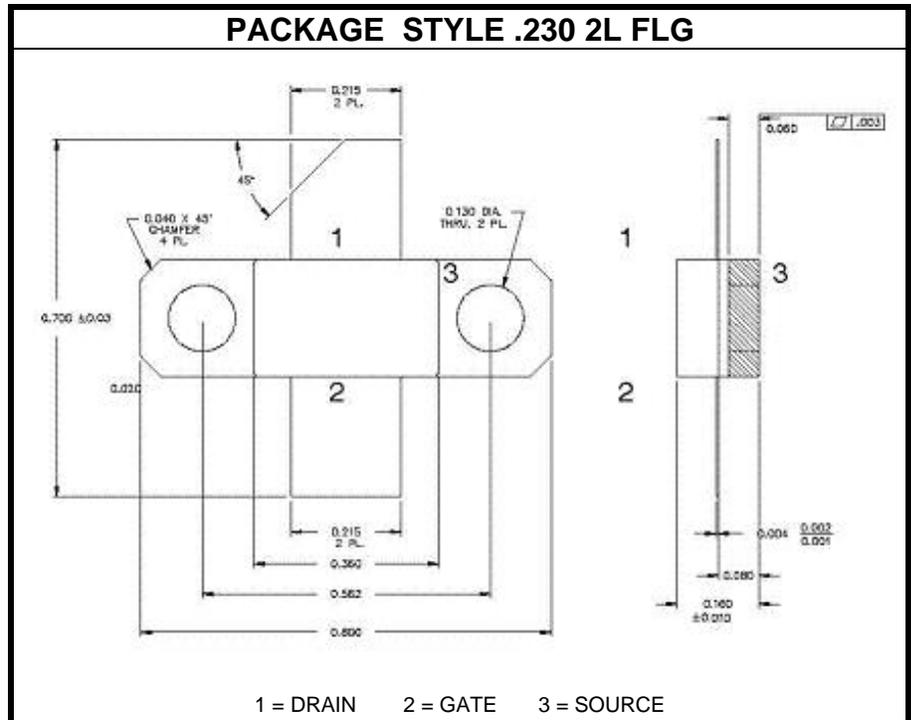
# RF FIELD-EFFECT POWER TRANSISTOR

**DESCRIPTION:**

The **ASI MRF9045LR1** is a high voltage, gold-metallized, laterally diffused metal oxide semiconductor. Ideal for today's RF power amplifier Applications.

**MAXIMUM RATINGS**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>I<sub>D</sub></b>    | 4.25 A                         |
| <b>V<sub>DSS</sub></b>  | 65 V                           |
| <b>V<sub>GS</sub></b>   | -0.5, +15 V                    |
| <b>P<sub>DISS</sub></b> | 117 W @ T <sub>C</sub> = 25 °C |
| <b>T<sub>J</sub></b>    | -65 °C to +200 °C              |
| <b>T<sub>STG</sub></b>  | -65 °C to +150 °C              |
| <b>θ<sub>JC</sub></b>   | 1.5 °C/W                       |


**CHARACTERISTICS**    T<sub>C</sub> = 25 °C

| SYMBOL                    | TEST CONDITIONS  | MINIMUM | TYPICAL | MAXIMUM | UNITS |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|-------|
| <b>BV<sub>DSS</sub></b>   | I <sub>D</sub> = 200 μA  | 65      |         |         | V     |
| <b>I<sub>DSS</sub></b>    | V <sub>DS</sub> = 28 V    V <sub>GS</sub> = 0 V  |         |         | 75      | μA    |
| <b>I<sub>GSS</sub></b>    | V <sub>DS</sub> = 0 V    V <sub>GS</sub> = 5.0 V   |         |         | 1.3     | μA    |
| <b>V<sub>GS(th)</sub></b> | I <sub>D</sub> = 400 μA    V <sub>DS</sub> = 10 V  |         |         | 4.8     | V     |
| <b>V<sub>DS(on)</sub></b> | I <sub>D</sub> = 1.0 A    V <sub>GS</sub> = 10 V   |         | 0.25    |         | V     |
| <b>g<sub>fs</sub></b>     | I <sub>D</sub> = 1.0 A    V <sub>DS</sub> = 10 V   |         | 3.0     |         | S     |
| <b>C<sub>iss</sub></b>    | V <sub>DS</sub> = 28 V    V <sub>GS</sub> = 0 V    f = 1.0 MHz                               |         | 73      |         | pF    |
| <b>C<sub>oss</sub></b>    |  |         | 23      |         |       |
| <b>C<sub>rss</sub></b>    |  |         | 1.2     |         |       |
| <b>G<sub>L</sub></b>      | V <sub>DS</sub> = 28 V    I <sub>DQ</sub> = 450 mA    P <sub>out</sub> = 6 W<br>f = 895 MHz  | 19      | 20      |         | dB    |
| <b>P1dB</b>               | V <sub>DS</sub> = 28 V    1 dB compression<br>I <sub>DQ</sub> = 450 mA    f = 895 MHz        | 45      | 60      |         | W     |
| <b>IMD</b>                | V <sub>DS</sub> = 28 V    I <sub>DQ</sub> = 450 mA    P <sub>OUT</sub> = 45 W<br>f = 895 MHz |         | 31      |         | dBc   |
| <b>IRL</b>                |  |         | 10      |         | dB    |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9